



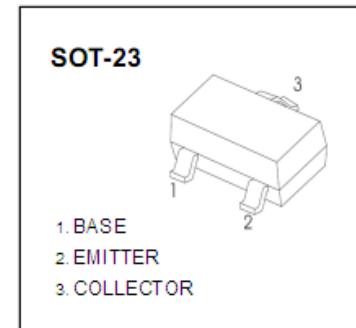
SLS SEMICONDUCTOR (SHENZHEN) CO.,LTD.

SOT-23 封装半导体晶体管/SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors**S9014 (NPN)****印章/Marking : J6****特点/Features :**

- 1、 h_{FE} 高, $h_{FE}=200 \sim 1000$;
- 2、 h_{FE} 线性特性好,
 $h_{FE}(0.1mA)/h_{FE}(2mA)=0.95(TYP)$;

用途/Applications :

用于低电平、低噪声的前置放大器,与 S9015 互补。

**极限参数/Absolute maximum ratings($T_a=25^\circ C$)**

参数/Parameter	符号/ Symbol	数值/Value	单位/Unit
集电极-基极电压/Collector-Base Voltage	V_{CBO}	50	V
集电极-发射极电压/Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	45	V
发射极-基极电压/Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5	V
集电极连续电流/Collector Current Continuous	I_c	0.1	A
集电极耗散功率/Collector Power Dissipation	P_c	0.2	W
结温/Junction Temperature	T_j	150	°C
储存温度/Storage Temperature	T_{stg}	-55~150	°C

电性能参数/Electrical characteristics ($T_a=25^\circ C$)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
集电极-基极击穿电压	$V_{BR(CBO)}$	$I_c=100 \mu A, I_e=0$	50			V
集电极-发射极击穿电压	$V_{BR(CEO)}$	$I_c=100 \mu A, I_b=0$	45			V
发射极-基极击穿电压	$V_{BR(EBO)}$	$I_e=100 \mu A, I_c=0$	5			V
集电极截止电流	I_{CBO}	$V_{CB}=50V, I_e=0$			0.1	μA
发射极截止电流	I_{EBO}	$V_{EB}=3V, I_c=0$			0.1	μA
集电极发射极穿透电流	I_{CEO}	$V_{CE}=35V, I_b=0$			0.1	μA
直流电流增益	h_{FE}	$V_{CE}=5V, I_c=1mA$	200		1000	
集电极-发射极饱和压降	$V_{CE(sat)}$	$I_c=100mA, I_b=5mA$			0.3	V
基极-发射极饱和压降	$V_{BE(sat)}$	$I_c=100mA, I_b=5mA$			1	V
特征频率	f_T	$V_{CE}=5V, I_c=10mA, f=30MHz$	150			MHz

 h_{FE} 分档/Classification of h_{FE}

档位/Rank	L	H
范围/Range	200~450	450~1000



SLS SEMICONDUCTOR (SHENZHEN) CO.,LTD.

SOT-23 封装半导体晶体管/SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors

典型特性曲线图/Typical Characteristics

